



LEADSUN

产品规格书

SPECIFICATION OF PRODUCTS

名 称：高压二极管

NAME: HIGH VOLTAGE DIODE

型 号： HVP-16

TYPE: HVP-16

鞍山雷盛电子有限公司

ANSNAN LEADSUN ELECTRONICS CO., LTD.



鞍山雷盛电子有限公司
ANSHAN LEADSUN ELECTRONICS CO., LTD.

1. 产品名称: 高压二极管
Name: High Voltage Diode
2. 适用范围: 本规格书适用于 HVP-16 型高压二极管
Range: HVP-16 High Voltage Diode

3. 概要:

Outline

3. 1 类型: 硅整流二极管
Type: Silicon diode
3. 2 结构: 环氧树脂封装
Structure: Molded by epoxy resin

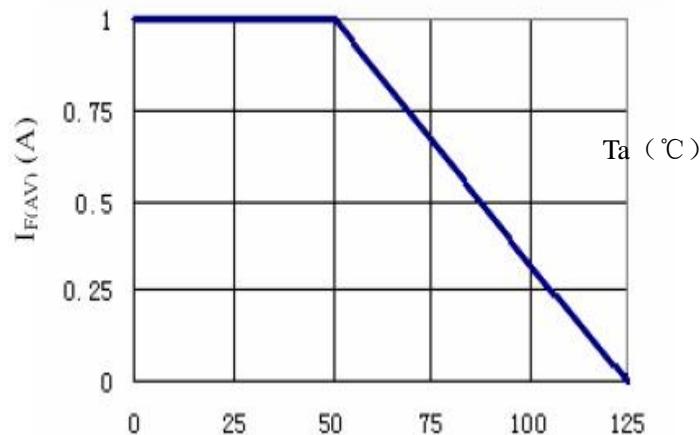
4. 绝对最大值 Absolute Max. Rating

序号 No.	项目 Item	符号 symbol	数值 Rating	单位 Unit	条件 Conditions
1	反向重复峰值电压 Repetitive Peak Reverse	V _{RRM}	16	KV	T _a =25°C I _R =0.5μA
2	反向工作峰值电压 Peak Working Reverse Voltage	V _{RWM}	16	KV	T _a =25°C I _R =0.5μA
3	反向不重复峰值电压 Non-Repetitive Peak Reverse Voltage	V _{RSM}	17.6	KV	T _a =25°C I _R =0.5μA
4	最高结温 Maximum Junction Temperature	T _{jmax}	120	°C	
5	贮存温度 Storage Temperature	T _{stg}	-40 ~ +120	°C	
6	平均正向电流 Average Forward Current	I _o	1.0	A	正弦半波 50Hz, 电阻负载, T _{break} =75°C
7	正向(不重复)浪涌电流 Surge Forward Current	I _{FSM}	50	A	正弦半波持续时间 0.01S 50Hz

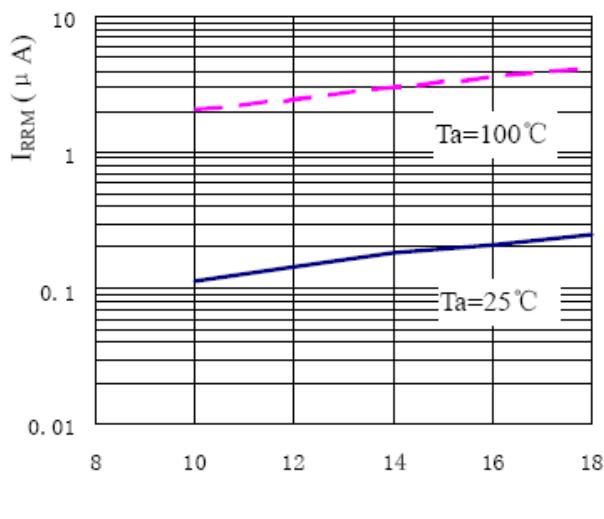
5. 电特性 Electric characteristic (if no other require, Tamb=25°C)

序号 No.	项目 Item	符号 symbol	数值 Rating	单位 Unit	条件 Conditions
1	常温反向漏电流 Normal Temperature Reverse Current	I _{RRM1}	5.0 max	μ A	V _R =V _{RRM} Tamb=25°C
2	高温反向漏电流 High Temperature Reverse Current	I _{RRM2}	50.0 max	μ A	V _R =V _{RRM} Tamb=100°C
3	正向电压 Reverse Breakdown Voltage	V _F	24.0	V	I _F = 1.0A

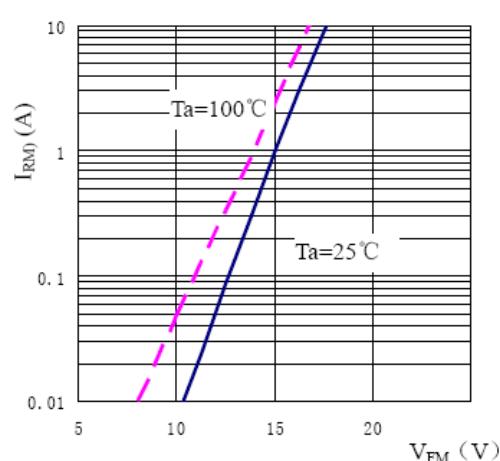
6. 特性曲线 Characteristic Curve



Forward average current derating curve



Reverse voltage characteristics curve



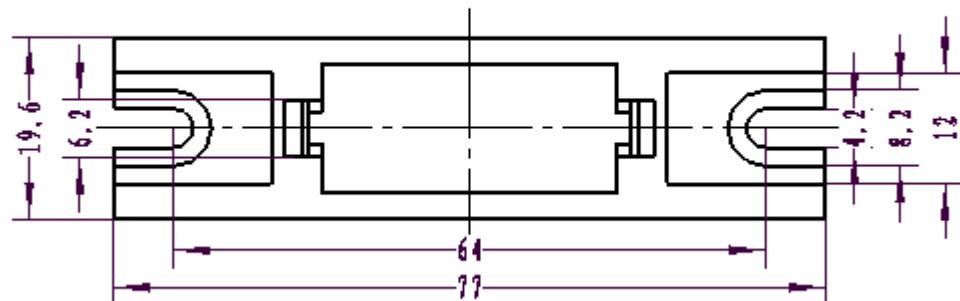
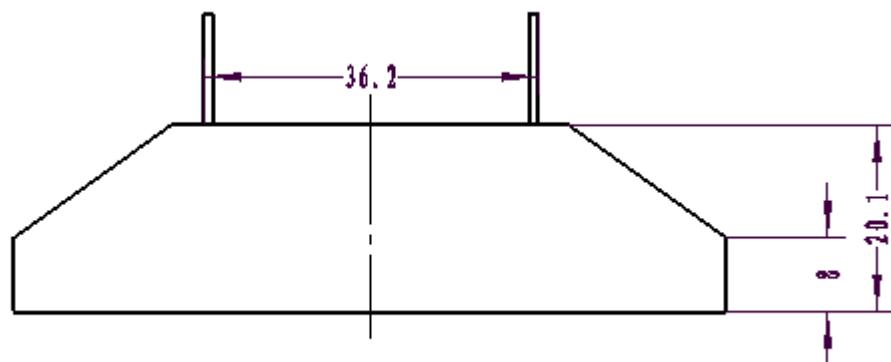
Forward voltage characteristics curve



鞍 山 雷 盛 电 子 有 限 公 司

ANSHAN LEADSUN ELECTRONICS CO., LTD.

7. 外形图示 Outline Dimension



8. 材料 Materials

NO	名 称 Name	材 料 型 号 Types of materials
1	正极端子 Male terminal	Φ 2.0 镀银(锡)插片 / Φ 2.0 silver (tin) plating filling-in pits
2	负极端子 Female terminal	Φ 4.0 镀银(锡)插片 / Φ 4.0 silver (tin) plating filling-in pits
3	封装 Package	环氧树脂 / Epoxy resin
4	芯片 Chip	硅 / Silicon